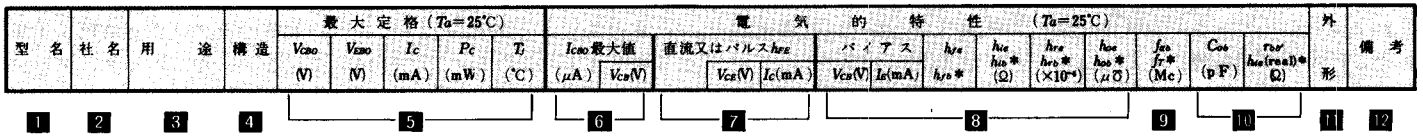
FOR USE BY ELECTRICIANS OVERSEAS:

最新トランジスタ規格表 (New Transistor Manual) lists all the transistors registered with the Electronic Industries Association of Japan (EIAJ), arranged in a manner easy to look up. We hope that you will make full use of the data provided in this manual by referring to the Japanese-English translation key given below.



1 TYPE NUMBER

2 ORIGINAL MANUFACTURER

3 USES

4 MATERIAL AND STRUCTURE

5 MAXIMUM RATINGS

6 I_{CBO} MAXIMUM VALUE AND V_{CB} VALUE (CRITERIA FOR MEASURING I_{CBO})

7 STANDARD VALUE OF DC/PULSE h_{FE} AND V_{CE} , I_C (CRITERIA FOR MEASURING DC/PULSE h_{FE})

8 STANDARD VALUE OF h PARAMETERS AND BIAS V_{CB} , I_E (CRITERIA FOR MEASURING h PARAMETERS)

* INDICATES VALUE IN GROUNDED-BASE OPERATION, OTHERWISE VALUE IN EMITTER-GROUNDED OPERATION.

9 $f_{\alpha b}$ OF RF CHARACTERISTIC, EXCEPT IN CASE OF * WHICH INDICATES VALUE OF f_T.

10 C_{ob} AND $r_{bb'}$ OF RF CHARACTERISTICS EXCEPT IN CASE OF * IN $r_{bb'}$ COLUMN WHICH INDICATES VALUE OF h_{ie} (real)

11 OUTLINE

12 REMARKS

：とコンプリ： COMPLEMENTARY TO ·····

	型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C)					電気的特性 (T_a = 25°C)													外形	備考
					V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流又はパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μ℧)	$f_{\alpha b}$ f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)		
	2SC2202																								
	〃 2203																								
	〃 2204	東芝	SW	Si.TMe	800	5	30A	250W (T_c=25°C)	150	1mA	800	>10	5	30A			t_{on}<1.5μS, t_f<1μS t_{stg}<4μS					400		266	
	〃 2205																								
	〃 2206	松下	RF	Si.EP	30	5	30	400	135	0.1	10	100	10	1	10	−1	NF=2.8dB (f=5MHz)				300*	1.3	22	151	
★	〃 2207	日立	PA	Si.E	80	4	8A	25W (T_c=25°C)	150	100	60	30~150	10	2A			P_O=14W, η>60% (f=27MHz, V_{CC}=12V, P_i=1W)							268	
	〃 2208	〃	SW	Si.EPa	120	7	5A	800	175	100	120	>1000	5	5A			t_{on}=0.4μS, t_{off}=4μS							84B	ダーリントン
	〃 2209	松下	PA	Si.EP	50	5	1.5A	10W (T_c=25°C)	150	1	20	120	5	1A	5	−500					150*	50	3.3k*	236	
	〃 2210	三洋	RF. Conv	〃	30	5	30	250	125	0.1	10	40~320	6	1	6	−1	NF=2.0dB (10V, 0.5mA, 455kHz)				90*	3.5	$C_c r_{bb'}$ 25pS	138	
	〃 2211																								
	〃 2212	ソニー	RF	Si.E	15	3	20	250	100	I_{CES} 0.2	10	30~170	10	3			h_{FE}=24dB (10V, 3mA, f=100MHz)					0.8	$C_c r_{bb'}$ 4pS	138D	
	〃 2213	〃	Osc.	Si.EPa	30	4	50	250	100	I_{CES} 0.2	15	70	10	5			h_{fe}=24dB (10V, 5mA, 100MHz)					1.1	$C_c r_{bb'}$ 10pS	138D	
	〃 2214	〃	PA. SW	〃	100	6	4A	10W (T_c=25°C)	175	0.5	50	100	2	100			t_d=45nS, t_{stg}=550nS t_f=30nS, t_f=60nS				140*	45	$C_c r_{bb'}$ 35pS	181	
	〃 2215	東芝	RF	Si.P	40	4	50	250	125	0.1	40	>30	10	4	10	−4	G_{pe}=32~40dB (V_{CE}=12V, I_C=4mA, f=45MHz)				>400*	C_{re} <1.2pF	$C_c r_{bb'}$ <30pS	138C	フォワードAGC
	〃 2216	〃	〃	Si.EP	50	4	50	300	125	0.1	50	40~140	12.5	12.5	12.5	−12.5	G_{pe}=29~36dB (V_{CE}=12.5V, I_C=12.5mA, f=45MHz)				>300*	0.8~2.0	$C_c r_{bb'}$ <25pS	138C	
	〃 2217	日電	RF. LN	Si.E	20	1.5	80	580	200	1	8	100	8	20	8	−20	$\|S_{21e}\|^2$=9.6dB (8V, 20mA, 2GHz)				8000*	C_{re} 0.4		306	
	〃 2218	〃	〃	〃	20	1.5	80	350	200	1	8	100	8	20	8	−20	$\|S_{21e}\|^2$=9.6dB (8V, 20mA, 2GHz)				8000*	C_{re} 0.4		320	
	〃 2219	〃	〃	〃	20	1.5	80	700 (T_c=81°C)	200	1	8	100	8	20	8	−20	$\|S_{21e}\|^2$=9.6dB (8V, 20mA, 2GHz)				8000*	C_{re} 0.4		311	
	〃 2220	東芝	SW	Si.TMe	500	5	30A	250W (T_c=25°C)	150	1mA	500	>10	5	30A			t_{on}<1.5μS, t_f<1μS t_{stg}<4μS					400		266	
	〃 2221	日電	RF. PA	Si.E	25	2.5	750	7.5W (T_c=25°C)	175	250	20	60	7	200			P_O=33dBm, η=70% (V_{CC}=7.2V, f=175MHz, P_i=23dBm)					C_{re} 7		84C	
	〃 2222	〃	〃	〃	25	2.5	1.5A	17W (T_c=25°C)	175	500	20	60	7	400			P_O=38dBm, η=70% (V_{CC}=7.2V, f=175MHz, P_i=28.5dBm)					C_{re} 12		129	
	〃 2223	〃	RF. LN	〃	30	4	20	150	125	0.1	25	90	6	1	6	−1	NF=3dB (6V, 1mA, 100MHz)				600*	1	$C_c r_{bb'}$ 12pS	176	
★	〃 2224	〃	PA	Si.EP	200	5	200	10W (T_c=25°C)	150	1	180	180	10	10	10	−10					100*	2	23*	167C	
	〃 2225																								
	〃 2226																								
	〃 2227																								
★	〃 2228	三洋	RF	Si.TP	160	5	50	750	125	1	160	40~320	10	10	30	−10					>50*	<7.5		294	
	〃 2229	東芝	AF. PA. SW	Si.T	200	5	50	800	150	0.1	200	70~240	5	10	30	−10					120*	3.5	25	241	
	〃 2230	〃	AF. RF	〃	200	5	100	800	150	0.1	200	120~400	10	10	10	−10					>50*	<7	30	241	
	〃 2231	〃	〃	〃	200	5	200	1.5W	150	0.1	200	100~320	10	50	10	−50					>50*	<10	50	178	